

Application Note AN-FET-001

Estudios de caracterización y rendimiento de transistores de efecto de campo (FET) utilizando μ Stat-i 400

En los últimos años, los transistores de efecto de campo (FET) se han utilizado muy comúnmente como una plataforma de detección para múltiples aplicaciones electroquímicas y biológicas.

Estos aparatos son prometedores transductores bioelectrónicos que permiten tanto el funcionamiento a bajo potencial como las medidas potenciométricas estables. En la actualidad, los FET se consideran una alternativa atractiva al uso de sistemas de detección

electroquímica convencionales en la comunidad científica.

Esta Application Note ofrece una guía detallada sobre el funcionamiento de los aparatos bipotenciostáticos DropSens de Metrohm para la caracterización de los FET y su uso como transductores. Se utiliza un solo dispositivo μ Stat-i 400, un bipotenciostato y galvanostato pequeño y portátil, para demostrar los siguientes experimentos.

INTRODUCCIÓN

Cuando los transistores de efecto de campo (FET) se funcionalizan correctamente con elementos de biorreconocimiento apropiados, como anticuerpos o enzimas, se demuestra que ofrecen una plataforma única para la transducción de eventos bioquímicos en tiempo real, específica y sin etiquetas. Por ejemplo, los FET correctamente funcionalizados pueden detectar la presencia de gases, iones y virus, e incluso

INSTRUMENTACIÓN Y SOFTWARE

El Metrohm DropSens μ Stat-i 400 se utilizó con el propósito de mostrar cómo conectar accesorios y realizar experimentos con FET. Este instrumento es un bipotenciostato y galvanostato portátil que puede funcionar de forma inalámbrica o conectarse a una computadora mediante un cable USB. El instrumento

Metrohm DropSens también ofrece el AUFET30 (Figura 1a), un transductor electroquímico de oro fijado a un sustrato de plástico. Esta plataforma está diseñada en un arreglo coplanar que integra todos los electrodos (canal y compuerta de fuente de drenaje) en una sola pieza para facilitar la fabricación de FET. Esta configuración asegura siempre que se mantenga la misma distancia de separación entre los electrodos y proporciona una fácil modificación del canal con el material semiconductor. El canal de fuente de drenaje es un sistema interdigitado de seis bandas en cada electrodo. El ancho del espacio de las bandas es de $30\ \mu\text{m}$, mientras que la longitud de las bandas es de $270\ \mu\text{m}$. El electrodo de puerta es un electrodo cuadrado ($9\ \text{mm}^2$) y se coloca a $2\ \text{mm}$ del canal de drenaje-fuente.

El conector dedicado BIDSCFET (Figura 1b) fue diseñado para que AUFET30 se conecte fácilmente a cualquier instrumento. Aquí, AUFET30 se muestra en la ranura ubicada en la parte frontal de este conector, mientras que en la parte trasera hay cuatro conectores banana hembra que combinan con los colores de los conectores banana macho de los cables provistos para una configuración intuitiva.

monitorear el crecimiento celular en tiempo real.

Estos biosensores basados en FET funcionan con un campo eléctrico que modula los portadores de carga a través de un material semiconductor. Dichos biosensores pueden convertir directamente interacciones biológicas específicas en señales eléctricas sin necesidad de una etiqueta electroactiva.

está controlado por el software DropView 8400, un software intuitivo dedicado y fácil de usar que permite a los usuarios realizar mediciones electroquímicas y ver la señal gráfica obtenida en tiempo real.

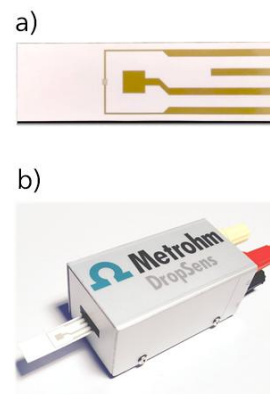


Figure 1. a) Plataforma AUFET30 para la fabricación de FETs. (b) Conector BIDSCFET.

conexión FET

Se incluye un conector de cable I-BICABSTAT con el bipotenciostato/galvanostato $\mu\text{Stat-i 400}$. Este cable tiene 5 conectores banana macho etiquetados como se describe en **Figura 2**.

Para realizar experimentos con FET, se describen diferentes arreglos de conexión dependiendo de la aplicación experimental deseada.

- Red – (WE1)
- Red – (S)
- Yellow – (XWE2)
- Black – (A)
- Blue – (R)
- Green – (\equiv)

Figure 2. Etiquetas para los 5 conectores banana diferentes

Conexión para caracterización FET

Durante la caracterización FET, la corriente de fuente de drenaje (I_{SD}) se evalúa comúnmente mediante el barrido del voltaje entre drenaje y fuente (V_{SD}) en diferentes pasos de voltaje de fuente de puerta (V_{SG}). Por lo tanto, la disposición de las conexiones es la siguiente:

- El conector banana XWE2 (amarillo) está conectado al **portón** electrodo.
- Los conectores tipo banana R (azul) y A (negro) están conectados al **fuelle** electrodo.

Para llevar a cabo la caracterización, varios *LSV+AD* los experimentos se realizan mientras se varía V_{SG} . Durante el experimento, el área de visualización de gráficos traza dos curvas simultáneamente: una azul correspondiente a I_{SD} *contra* V_{SD} y uno rojo correspondiente a I_{GRAMO} *contra* V_{SD} . Después de realizar los diferentes experimentos *LSV+AD*, el área de visualización de gráficos muestra un gráfico similar al de **figura 3**.

Las líneas azules muestran la relación lineal entre I_{SD} y V_{SD} obtenido a diferentes V_{SG} desde $-0,40$ V hasta $+0,40$ V. La dependencia lineal del dispositivo evaluado confirma que el contacto óhmico se mantiene entre los electrodos de oro del canal de fuente de drenaje y la película semiconductor subyacente.

- Los conectores banana WE1 (rojo) y S (rojo) se conectan al **drenar** electrodo.

Una vez realizadas las conexiones, seleccione el *LSV+AD* técnica en el software DropView 8400. Los parámetros del experimento se pueden configurar en las ventanas de parámetros del software.

- **Inicio:** valor inicial para V_{SD}
- **Fin:** Valor final para V_{SD}
- **E2:** Voltaje de puerta V_{SG}

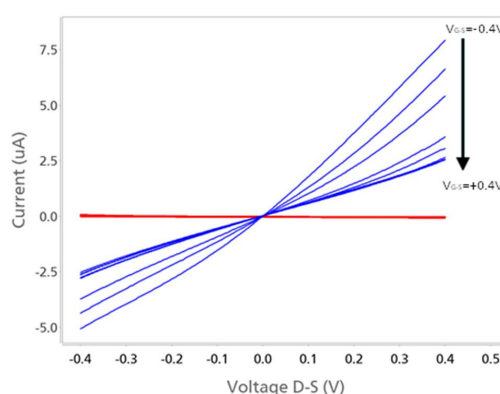


Figure 3. Gráfico de ID-S (azul) e IG-S (rojo) versus VD-S obtenido en diferentes VG-S con el software DropView 8400.

Conexión para curvas de transferencia IV: barrido de tensión puerta-fuente aplicando tensión fija en canal drenaje-fuente

Para obtener las curvas de transferencia típicas, la corriente drenaje-fuente (I_{SD}) se registra a un voltaje fijo mientras que V_{SG} es barrido. Después de la caracterización (figura 3), una gran variación en I_{SD} se pueden observar valores dependiendo de la V aplicada V_{SG} en una V_{SD} de +0,40 V. Por eso, esta V_{SD} se ha seleccionado un valor (+0,40 V) para realizar el siguiente experimento de curvas de transferencia. El procedimiento de operación es muy similar a la descripción anterior, pero las conexiones deben realizarse como se describe a continuación.

El procedimiento de operación es muy similar a la descripción anterior, pero las conexiones deben realizarse como se describe a continuación.

- Los conectores banana WE1 (rojo) y S (rojo) se conectan al **portón** electrodo.

Después de comenzar el experimento, el área de visualización de gráficos muestra dos curvas simultáneamente: una roja correspondiente a la curva de transferencia IV (I_{SD} contra V_{SG}), y uno azul relacionado con la corriente de fuga (I_{SG} contra V_{SG}) (Figura 4).

- Los conectores tipo banana R (azul) y A (negro) están conectados al **fuelle** electrodo.
- El conector banana XWE2 (amarillo) está conectado al **drenar** electrodo.

Una vez realizadas las conexiones, seleccione el *LSV+AD* técnica en el software DropView 8400. Los parámetros del experimento se pueden configurar en las ventanas de parámetros del software.

- **Inicio:** valor inicial para V_{SG}
- **Fin:** valor final para V_{SG}
- **E2:** tensión drenaje-fuente

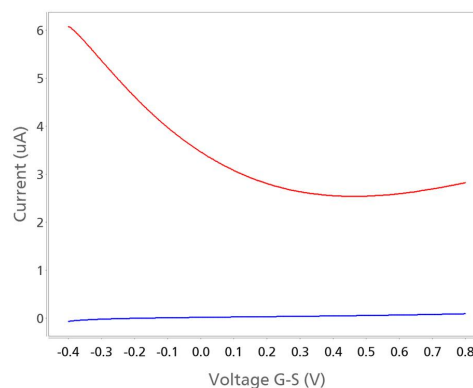


Figure 4. Gráfico de la curva de transferencia IV (I_{SD} , línea roja) y corriente de fuga (I_{SG} , línea azul) frente a V_{G-S} obtenida con el software DropView 8400.

Conexión para medidas continuas

Para algunas aplicaciones es necesario realizar medidas en modo continuo, ya que una vez seleccionados los parámetros óptimos se aplica un voltaje fijo entre puerta y fuente, y otro voltaje fijo también se aplica al drenaje. En este caso, la configuración operativa es la misma que la utilizada para las curvas de transferencia. Sin embargo, en esta situación se emplea una técnica diferente. *Detección amperométrica* se selecciona en el software DropView 8400. En las ventanas de parámetros del software, seleccione «2» como el número de canales (Figura 5a). Posteriormente, haga clic en la pestaña de parámetros multicanal dentro de la ventana de parámetros (Figura 5b), luego configure el voltaje de fuente de puerta en el canal 1 y el voltaje de fuente de drenaje en el canal 2. Después de comenzar el experimento, el área de visualización de gráficos mostrará dos curvas, una roja y una azul relacionadas con I_{SD} *contra* el tiempo y $y_{o_{SG}}$ *contra* tiempo, respectivamente.

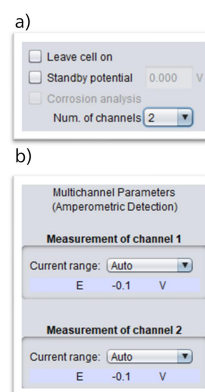


Figure 5. a) Sección de la ventana de parámetros en DropView 8400 donde se debe seleccionar el número de canales. (b) La pestaña de parámetros Multicanal dentro de la ventana de parámetros donde E del canal 1 corresponde a VG-S y E del canal 2 corresponde a VD-S.

CONCLUSIÓN

Los bipotenciostatos Metrohm DropSens permiten a los usuarios mostrar simultáneamente las corrientes de fuente de compuerta y fuente de drenaje en una figura única, lo que significa que la curva de transferencia IV y la corriente de fuga se pueden obtener para cada experimento. El mismo protocolo escrito en esta nota de aplicación se puede seguir con el μ Stat 400.

Además, AUFET30 es un transductor electroquímico para el fácil desarrollo de FET. Junto con el conector dedicado BIDSCFET, facilita la adaptación a cualquier bipotenciostato para realizar mediciones confiables con mayor sensibilidad que las configuraciones convencionales de celdas electroquímicas de tres electrodos.

CONTACT

Metrohm Hispania
Calle Aguacate 15
28044 Madrid

mh@metrohm.es

CONFIGURACIÓN



Instrumento de análisis de impedancia-bipotenciostato-galvanostato (EIS) μ Stat-i 400

μ Stat-i 400 es un instrumento de análisis de impedancia-bipotenciostato-galvanostato (EIS) portátil que se puede aplicar para medidas voltamperométricas, amperométricas, potenciométricas y EIS, y que se puede utilizar con configuraciones de uno o dos electrodos de trabajo. Alimentado con baterías de iones de litio, puede conectarse fácilmente a un ordenador mediante USB y Bluetooth®.



Transistores de oro de efecto campo flexibles con puerta coplanar

Estos dispositivos flexibles desechables para transistor de efecto campo (FET) están hechos de oro sobre un sustrato de plástico. Estos electrodos son útiles para obtener fases de detección.